

3 2

4 5 3

IV-IV' V-V'

가

가

가

가

가 가

(pixel defect)
가

가

가

가

가
(white defect)
(black defect)

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

1

2

1

1
1

1

1

II-II'

2

(100, 200)

(300)

(100)

(200)

1

(gate line)(121)

(100)

(110)

(121)

(123)

(121)

가

(121)

(storage electrode line)(131)

(190)

가

175)
(270)
de)

(storage electrode)(133)

가

(190)
(normally white mo

(131, 133)

가

가

(190)

(270)

가

(normally black

mode) (131, 133) (110) (200) (131, 133) 가
 (270) (off)

(121) (133) ,
 (121p, 133p) , IZO (indium zinc oxide) ITO(indium t
 in oxide) (Mo), (Cr) / -
 (121q, 133q) (121p, 133p) (121q, 133q)
 (Nd)

(121p, 133p) (121q, 133q) , (110)
 30-80 °

(121) (131, 133) (SiNx) (140)

(140) (hydrogenated amorphous silicon)
 (151)가 (151) (154)가
 (123) (151) (121)
 (121)

(151) n n+ (161, 165)가 (161
) (ohmic contact)(161, 165)가
 (154) (163) 가 (163) (165) (151)

(151) (161, 165) 30-80 °
 (161, 165) (140) (data line)(171)
 (drain electrode)(175)

(171) (121) (171)
 (175) 가 가 (source electrode)(173) (171) (
 173) (175) (123)
 (123), (173) (175) (151) (154)
 (173) (175) (154)

(175) (133)

(171) (175) (Mo), (Cr)

(171) (175) (121) 가 30-80 °

(161, 165) (151) (171) (175)
 (151) (171) (175) 가 (151) 가 (173) (175)
 (151) (171) (171) (121) (121)

(171) (175) (151) (175)
 가 , , , (230
 R, 230G, 230B) (230R, 230G, 230B)가 , , , (230
 , , ,
 (171) 가 (171) (129, 179)

, , (230R, 230G, 230B)
 , 가 .

, , (230R, 230G, 230B) 가 ,
 (plasma enhanced chemical vapor deposition, PECVD) a-Si:C:O, a-Si:O:F
 , (180) .

(180) (175) (171) (179) (183, 182)
 , (140) (121) (129) (181)
 , (175) 가 , (183) (175) , (230R, 230G, 230B)
 G, 230B) (230R, 230G, 230B) 가 . (180)

(180) IZO ITO (190) (81, 82)가 .

(190) (183) (175) (175)
 가 .

가 (190) 가 (200) (270)
 (100, 200) (300) .

가 , 가 (190) (“ ”)
 , (190) (121)(
)

(131) (133) 가 (190) (175)
 (140)

(190) (121) (171) ,

(81, 82) (181, 182) (129) (179)
 . (81, 82) (121) (171) (129, 179)

(121), (171) (175) (180) (230R, 230G, 230B)
 가 (190) (92, 97)가

1 (100) (200)
 (300) 1

1 가 가
 (190) 가

, (230R, 230G, 230B)가 (100)
 , (200) 가 .

0) , (140) (20)
 (180) (1183) S , (175) (133)
 , D (normally black mode) (175) (133) (190)
 (190) (270)

(133)

(190)

(175)

가

(175)

(133)

(140)

가

1
9 11

가

3
3

2

IV-IV' V-V'

4 5

3

5

1

2

2

(110)

(154)

(123)

(121)

(140),

(161)

(151),
(165)가

(163)

(161, 165)

(140)

(177)가

(153)

(151),
(165)가

(171),

(161, 165)

(140)

(81, 82)가

(181, 182, 183)

(180)

,

(180)

(180) /

(190)

1

2

(151)

가

(154)

2

(171)

(175),

(161, 165)

가

2
1

(57)

1.

가

가

가

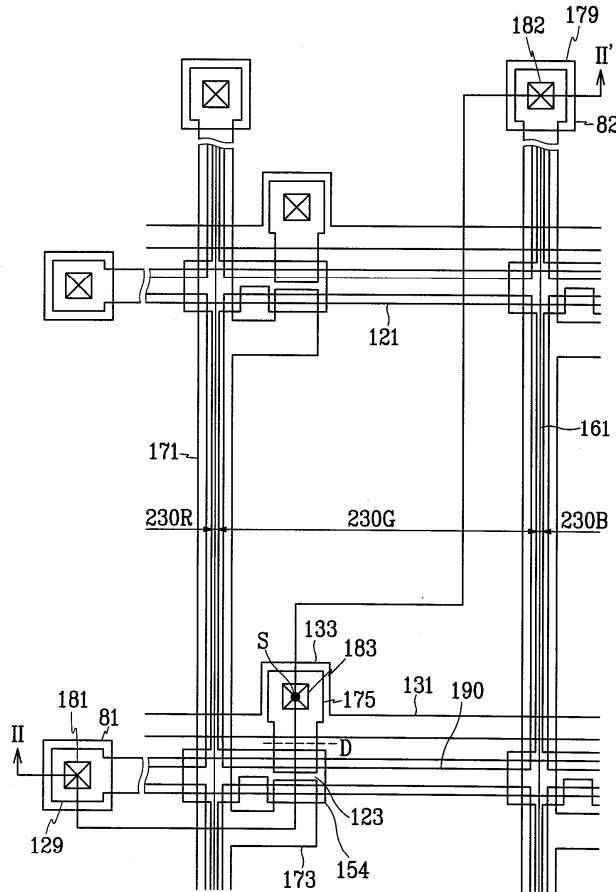
가
가

8.

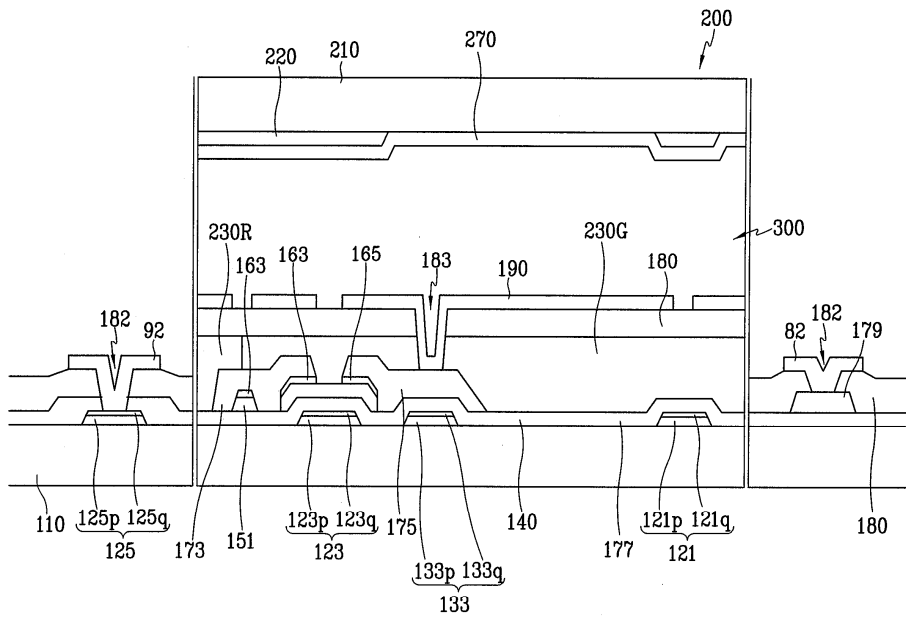
5 ,

가

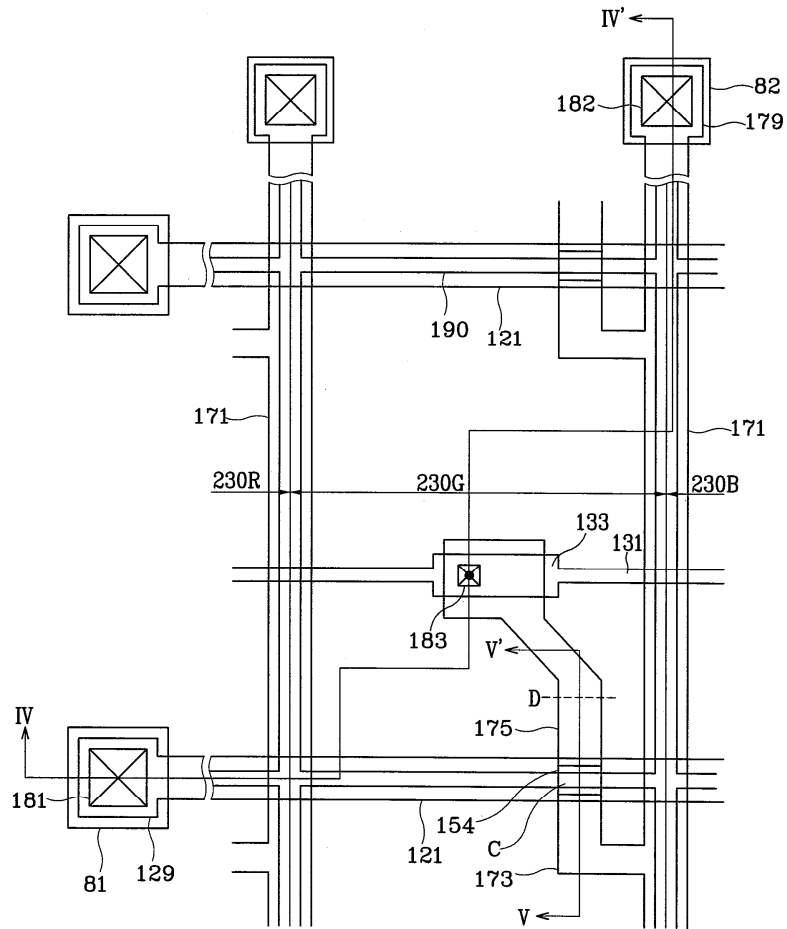
1



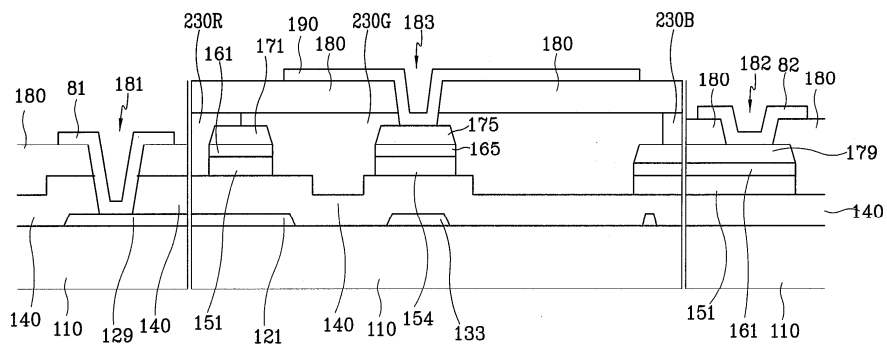
2



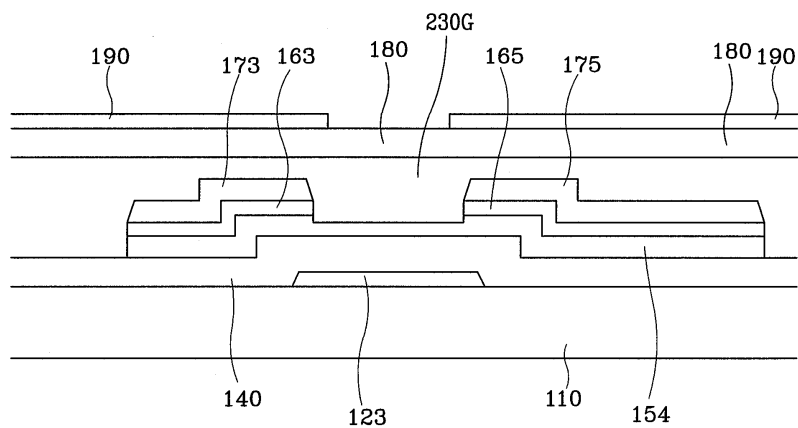
3



4



5



专利名称(译)	薄膜晶体管显示面板及包括其的液晶显示装置的修复方法		
公开(公告)号	KR1020050001709A	公开(公告)日	2005-01-07
申请号	KR1020030041989	申请日	2003-06-26
[标]申请(专利权)人(译)	三星电子株式会社		
申请(专利权)人(译)	三星电子有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	三星电子有限公司		
[标]发明人	KIM KYUNGWOOK 김경욱 KIM DONGGYU 김동규		
发明人	김경욱 김동규		
IPC分类号	G02F1/136 G02F1/1362 G09F9/00 H01L29/786 G02F1/1368 G02F1/1343		
CPC分类号	G02F1/136259 G02F1/136213 G02F2001/136268 G02F2001/136222		
其他公开文献	KR101006434B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

用途：提供TFT（薄膜晶体管）面板和包括其的LCD（液晶显示器）的修复方法，以容易地修复具有独立存储电容线的从属布线类型中的白色缺陷。

